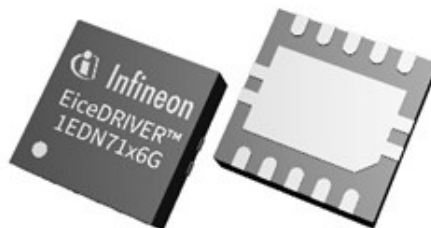


EiceDRIVER™ 1EDN71x6G 200VハイサイドTDIゲートドライバーIC (GaN SG HEMT, MOSFET用)

1EDN71x6Gは、インフィニオン CoolGaN™ ショットキーゲート(SG) HEMTや、その他のGaN SG HEMTやSi MOSFETの駆動に最適化された、シングルチャネルのゲートドライバーICです。高速スイッチングトランジスタを用いた高性能なシステムを設計できる、重要な機能がいくつか搭載されています。これらの機能には、Truly Differential Input (TDI)、4つの駆動強度オプション、アクティブミラークランプ、ブートストラップ電圧クランプ、調整可能なチャージポンプなどがあります。TDI機能により、同相電圧が150V (スタティック) および200V (ダイナミック) 以下であれば、ゲートドライバーの出力状態は、ドライバーの基準 (グラウンド) 電位に関係なく、2つの入力の電圧差によってのみ制御されます。これにより、ローサイドアプリケーションにおけるグラウンドバウンスによる誤作動のリスクを排除するとともに、ハイサイドアプリケーションにも対応することができます。



主な特長

- > Truly differential logic input (TDI)
- > 4つの駆動力
- > アクティブ ミラー クランプ
- > オプションの負の充電ポンプ
- > アクティブ ブートストラップ クランプ

主な利点

- > ハイサイド駆動とローサイドのグラウンドバウンス耐性
- > 外付けゲート抵抗なしでスイッチング速度を最適化
- > アクティブ ミラー クランプで誘導ターンオンを回避
- > オプションのチャージポンプにより、必要に応じて誘発されるターンオンイミュニティを追加することができます。
- > デッドタイム中のブートストラップ コンデンサーの過充電を回避

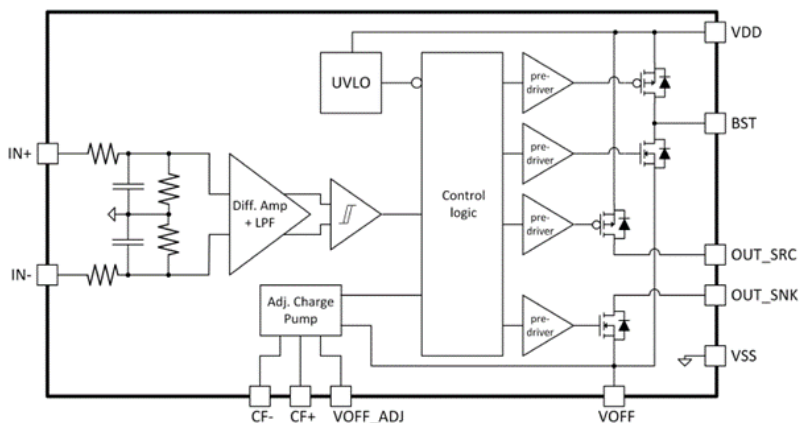
競合製品に対する優位性

ダイナミック電圧200V、TDI、4種類の駆動力、スプリアススイッチングに対する堅牢性

対象アプリケーション

- > テレコム
- > サーバー
- > DC-DC
- > モータードライブ
- > クラスDオーディオ
- > AI

システム図 : 天井扇



製品関連情報/オンラインサポート

[製品ファミリーページ](#)

製品概要および製品データシート ページへのリンク

発注可能な部品番号	SP 番号	パッケージ
1EDN7116GXTMA1	SP005405019	PG-VSON-10-4
1EDN7126GXTMA1	SP005422696	PG-VSON-10-4
1EDN7136GXTMA1	SP005422700	PG-VSON-10-4
1EDN7146GXTMA1	SP005422704	PG-VSON-10-4

【EiceDRIVER™ 1EDN71x6G 200VハイサイドTDIゲートドライバIC (GaN SG HEMT, MOSFET用)】

FAQ

1. Is the Infineon GaN gate driver suitable only for Infineon CoolGaN™ SG HEMT?

No, the 1EDN71x6G is suitable for any GaN Schottky gate HEMT and also silicon MOSFETs.

2. What are the key differences between driving GaN HEMT and silicon MOSFETs?

Lower charges, faster dv/dt, lower gate voltage rating and threshold.